



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

КАФЕДРА КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ (ИУ6)

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 09.03.01 Информатика и вычислительная техника

ОТЧЕТ

По лабораторной работе №3

Название: Ключевой режим работы транзистора
Дисциплина: Электроника

Студент

ИУ-426
(Группа)

(Подпись, дата)

С.В.Астахов
(И.О. Фамилия)

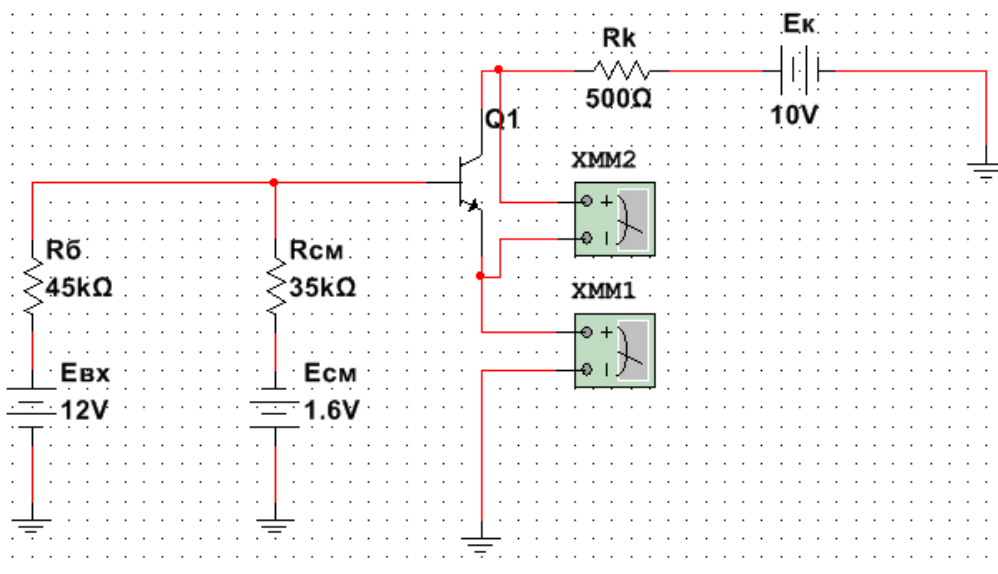
Преподаватель

(Подпись, дата)

(И.О. Фамилия)

Цель: исследовать статические режимы и переходные процессы в схеме простого транзисторного ключа.

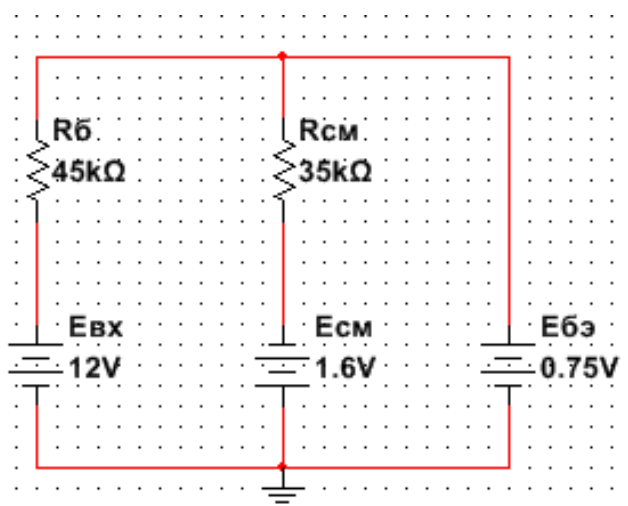
Нахождение «граничной точки»



Исходная схема

Чтобы найти "граничную точку", необходимо увеличить ток коллектора, уменьшив значение сопротивления. Найдём такое значение сопротивления, чтобы соблюдалось соотношение:

$$\frac{E_k}{R_k} = B * I_B$$



Упрощенная схема

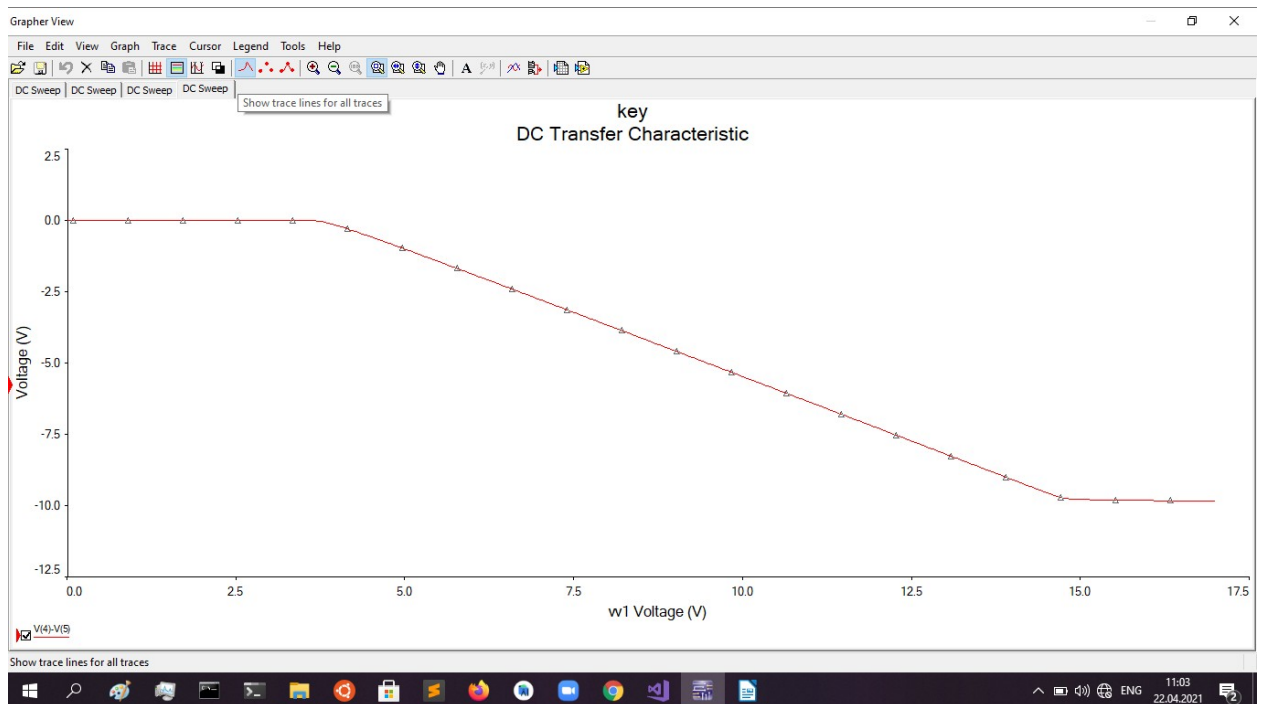
С помощью метода контурных токов вычислим ток базы I_B

$$I_{B1} = \frac{13,6}{45000} - \frac{80000 \cdot (0,75 + 1,6)}{45000 \cdot 35000} = 0,000183 \text{ A}$$

$$B \cdot I = 120 \cdot 0,000183 = \frac{9}{R_k}$$

$$R_k = 410 \text{ Ом}$$

Подставим параметры в исходную схему и проведем DC-sweep анализ:



Передаточная характеристика

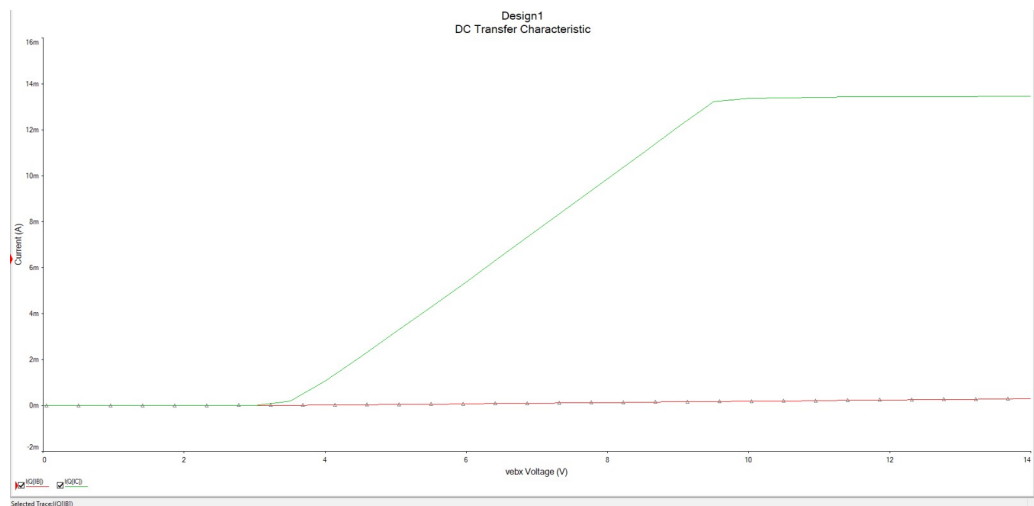


График зависимости токов базы и тока коллектора от входного напряжения

Из графика можно найти $I_B = 58.2 \text{ мкА}$, $I_k = 6,9 \text{ мА}$

$\beta = I_k / I_B = 6900 \text{ мкА} / 58.2 \text{ мкА} = 118.5$

Исследование статического коэффициента усиления по току β

Для исследования в схеме необходимо менять R_k и снимать значения I_B , I_k и $U_{кэ}$. Также рассчитываем коэффициент $\beta = I_k / I_B$

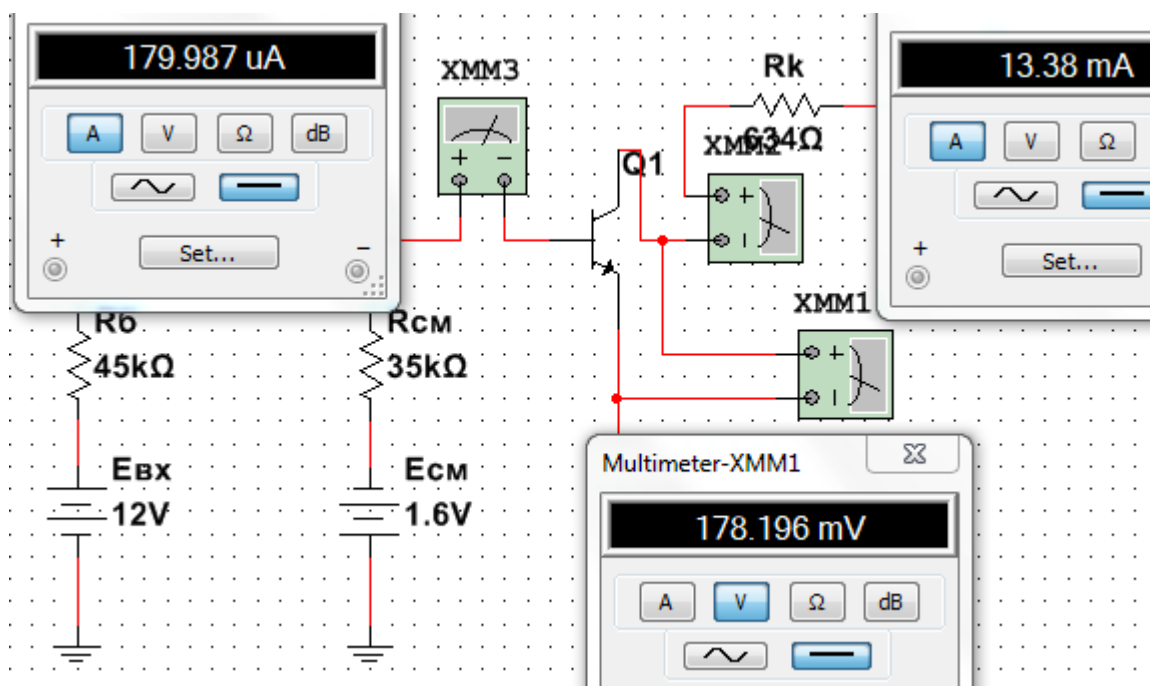


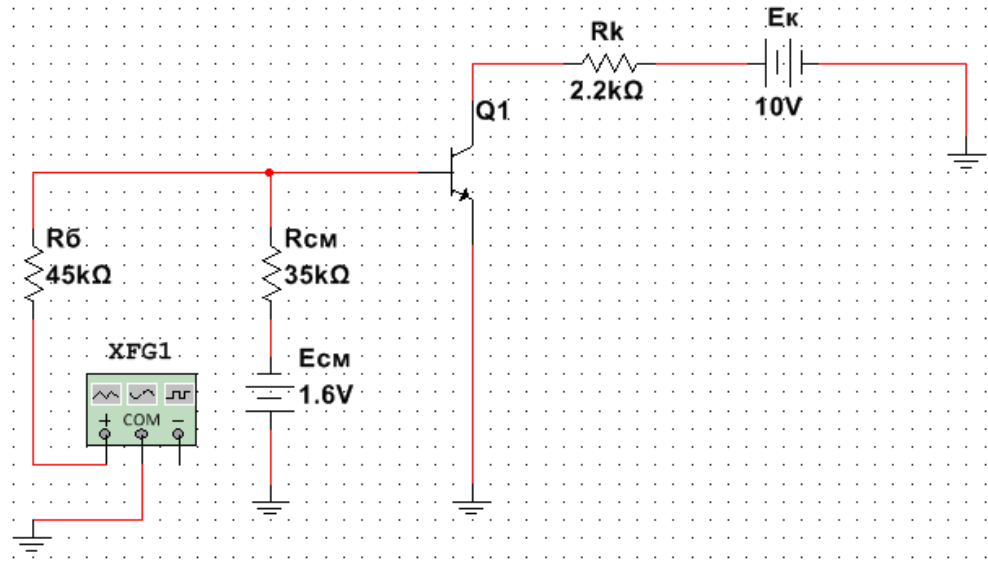
Схема для исследования статического коэффициента усиления по току β при различных R_k

Исследование статического коэффициента усиления по току β при различных R_k :

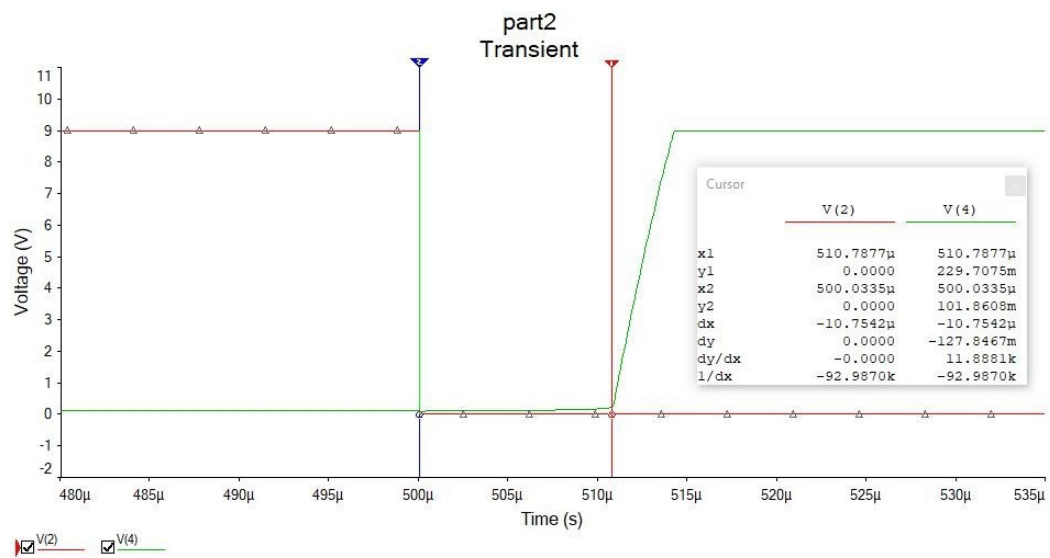
$R_k, \text{ Ом}$	$U_{кэ}, \text{ мВ}$	$I_B, \text{ мкА}$	$I_k, \text{ мА}$	β
10	8849,0	125,4	15,0	119,6
200	5989,1	125,4	15,0	119,6
410	182,7	125,6	13,6	108,2
1000	133,0	126,3	8,9	70,4
2000	102,2	127,4	4,4	34,6
5000	74,6	128,8	1,8	13,9

Исследование динамических характеристик

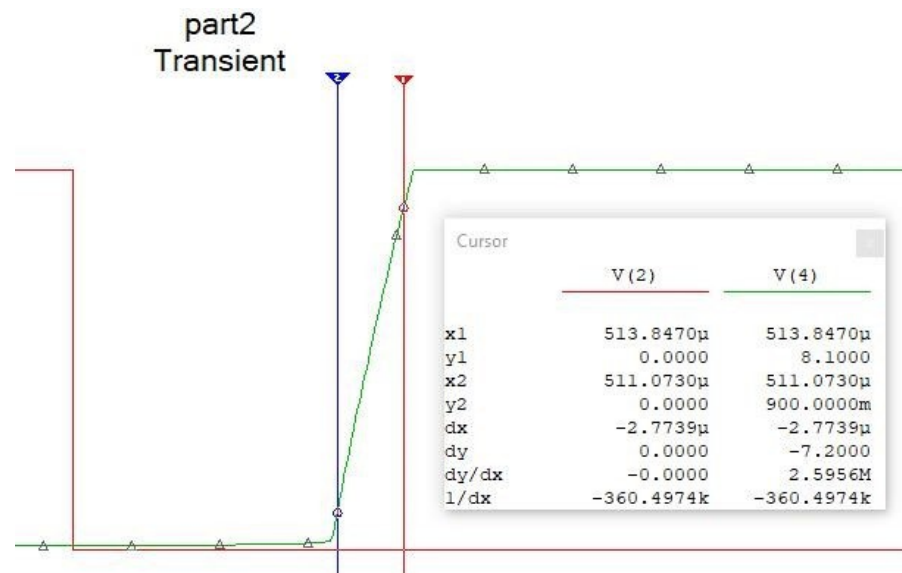
Рассмотрим изменение t_{ϕ} , $t_{\text{рас}}$, t_c при различном входном периодическом напряжении. Частоту генератора примем равной 1 КГц, сигнал прямоугольный.



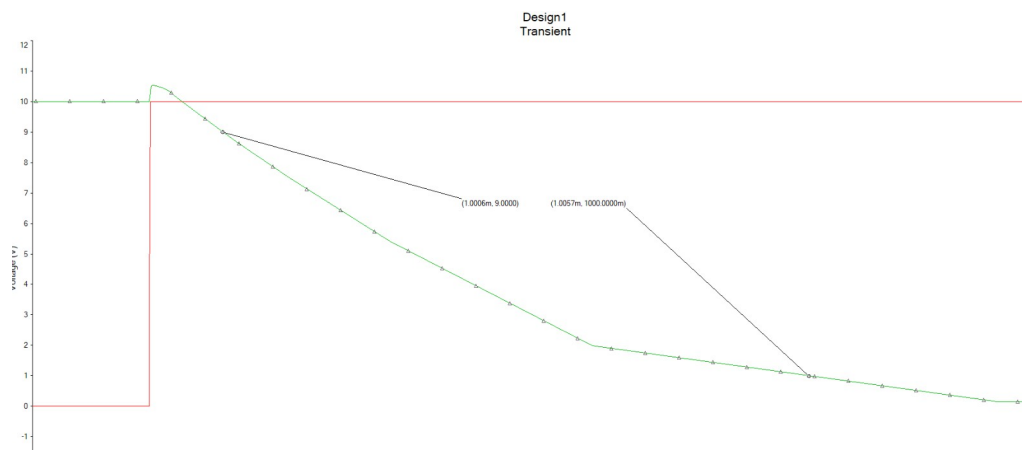
Рассматриваемая схема



Измерение времени ($R_k = 2200 \text{ Ом}$)



Измерение времени ($R_k = 2200 \text{ Ом}$)



Измерение времени ($R_k = 2200 \text{ Ом}$)

Из рисунков выше можно найти t_f , $t_{рас}$, t_c . Найдем эти величины для разных значений амплитуды входного сигнала.

Ег, В	Тф, мкс	Трас, мкс	Тс, мкс
5	5,2	4,5	2,0
10	2,9	10,7	2,7
12.5	2,4	15,0	3,5
15	1,8	19,1	3,4

Из таблицы видно, что при увеличении амплитуды входного сигнала время рассасывания электронов увеличивается и длительность среза увеличиваются, а длительность фронта уменьшается.

Аналитический расчет

$$J_{б1} = \frac{E_{BX} + E_{CM}}{R_б} - (R_б + R_{CM}) * \frac{E_{CM} + U_{бэ}}{R_{CM} * R_б} = 0,0002 \text{ A}$$

$$J_{б2} = \frac{U_{бэ}}{R_{CM}} + \frac{E_{CM}}{R_{CM}} = 0.00009 \text{ A}$$

$$\tau_H = (3 \dots 20) \tau_B = 3 \tau_B = 2.8 * 10^{-5} \text{ c}$$

$$f_B = \frac{f\alpha}{B + 1} = 16529 \text{ Гц}$$

$$J_{бH} = \frac{E_K}{B * R_K} = 0.0000375 \text{ A}$$

$$\tau_B = \frac{1}{2 * \pi * f_B} = 9.6 * 10^{-6} \text{ c}$$

$$S = \frac{J_{б1}}{J_{бH}} = 5.33$$

$$\tau_\Phi = \tau_B * \ln\left(\frac{S - 0,1}{S - 0,9}\right) = 1.6 * 10^{-6} \text{ c}$$

$$\tau_{рас} = \tau_H * \ln\left(\frac{S * J_{бH} + J_{б2}}{J_{бH} + J_{б2}}\right) = 22 * 10^{-6} \text{ c}$$

$$\tau_C = \tau_B * \ln\left(\frac{\frac{J_{б1}}{S} + J_{б2}}{J_{б2}}\right) = 3.34 * 10^{-6} \text{ c}$$

Сравнительная таблица

	Ег, В	тф, мкс	трас, мкс	тс, мкс
Замеренные значения	10	2,9	10,7	2,7
Вычисленные значения	10	1,6	22	3,3
Разница	0	1,3	11,3	0,6

Влияние форсирующего конденсатора на параметры переходных процессов

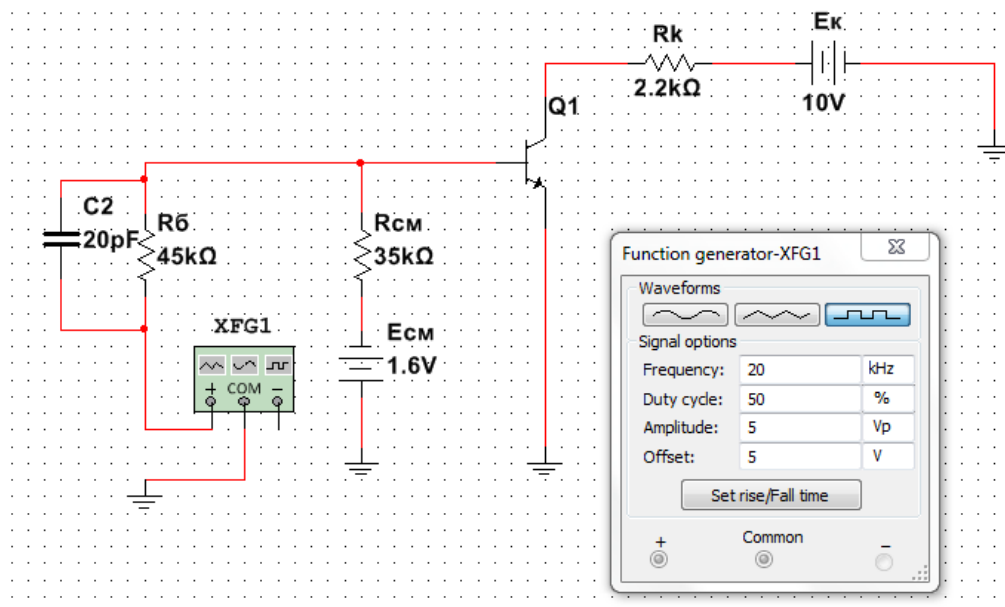
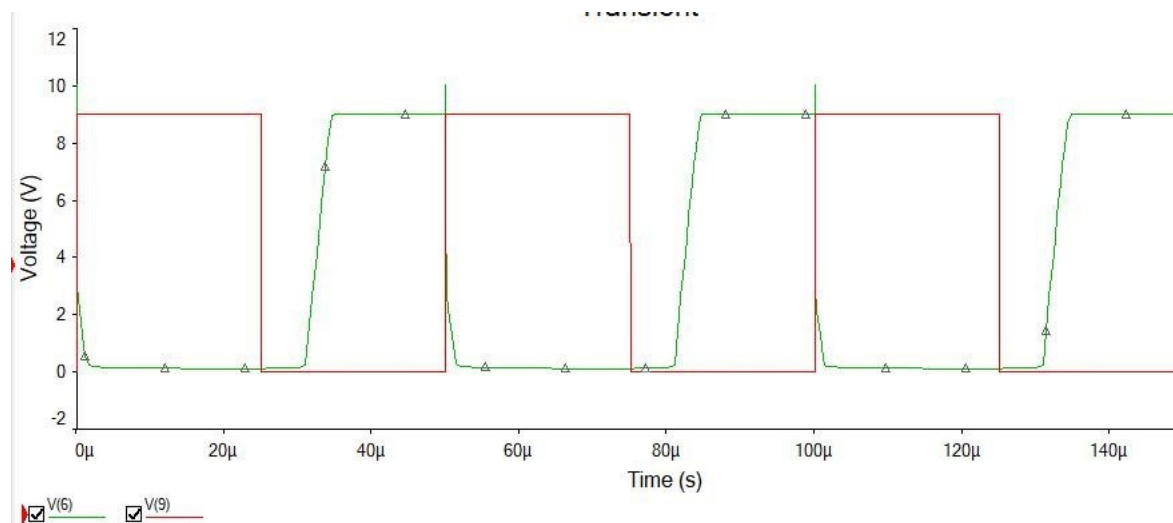
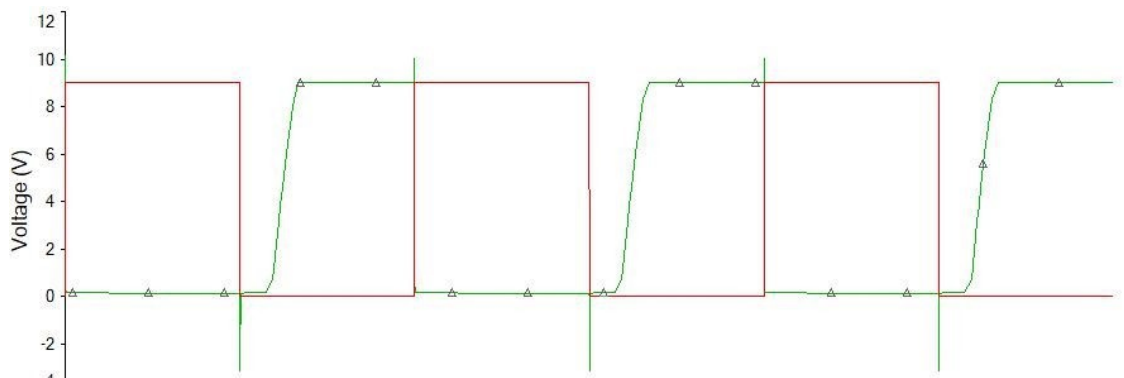


Схема для исследования влияния форсирующего конденсатора



Влияние на динамические характеристики форсирующего конденсатора 20pF



Влияние на динамические характеристики форсирующего конденсатора 40pF

Как видно, при увеличении форсирующей емкости уменьшается время длительности фронта и время рассасывания электронов.

Влияние ёмкостной нагрузки на параметры переходных процессов

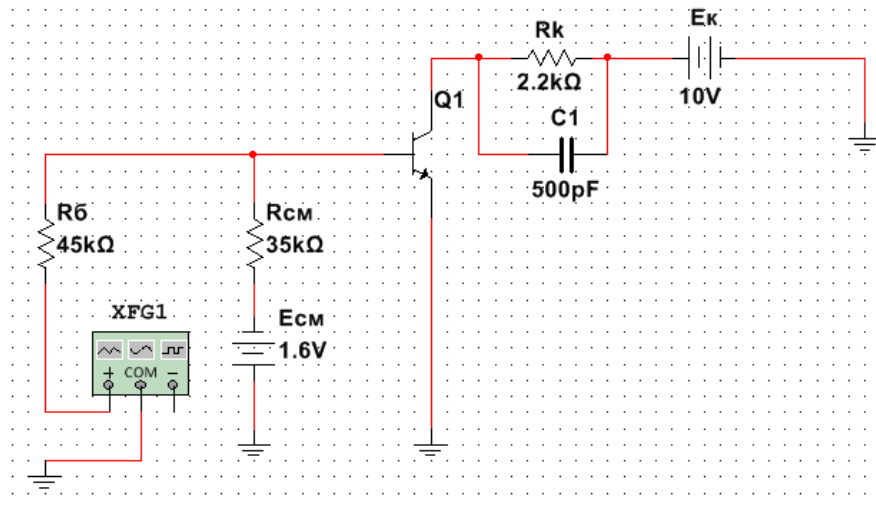
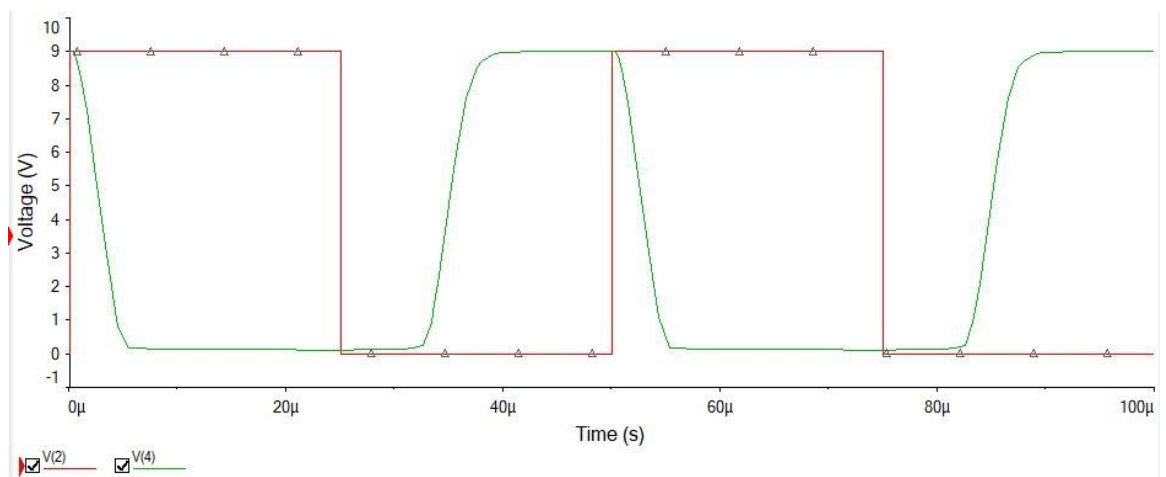
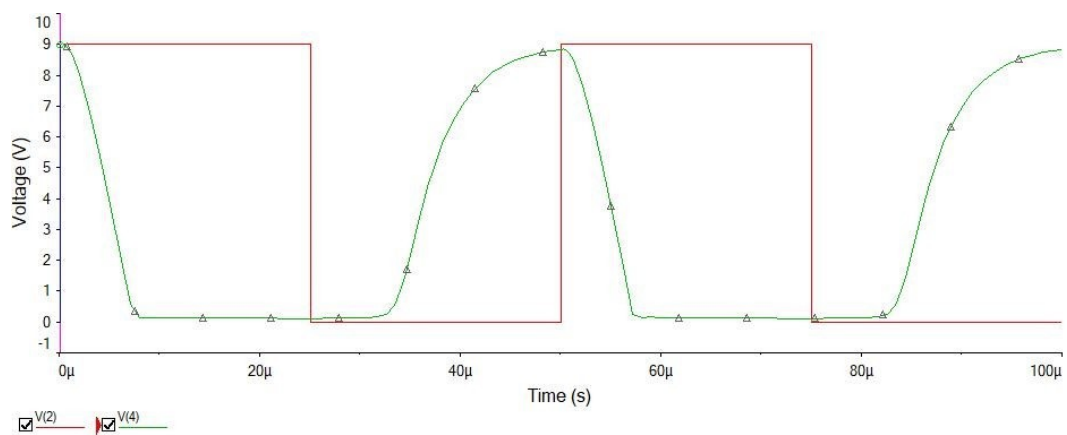


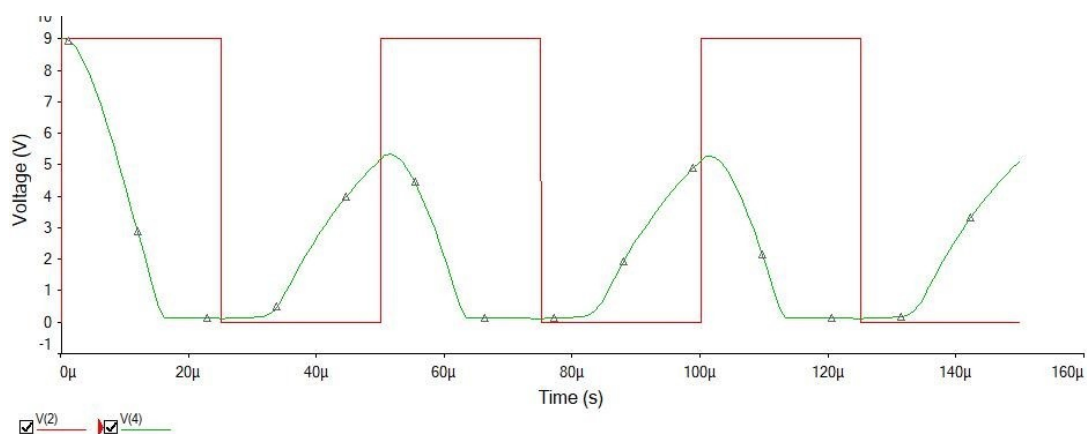
Схема для исследования влияния емкостной нагрузки



Влияние на динамические характеристики емкости нагрузки 500pF



Влияние на динамические характеристики емкости нагрузки 2nF



Влияние на динамические характеристики емкости нагрузки 10nF

C, pF	t_{ϕ} , мкс	$t_{рас}$, мкс	t_c , мкс
0,5	3,4	7,5	3,7
2	5,0	7,1	9,4
10	10,3	7,3	16,4

Как видно, при увеличении нагрузочной емкости не изменяется время рассасывания и увеличиваются остальные временные параметры.

Инверсное запырание ключа

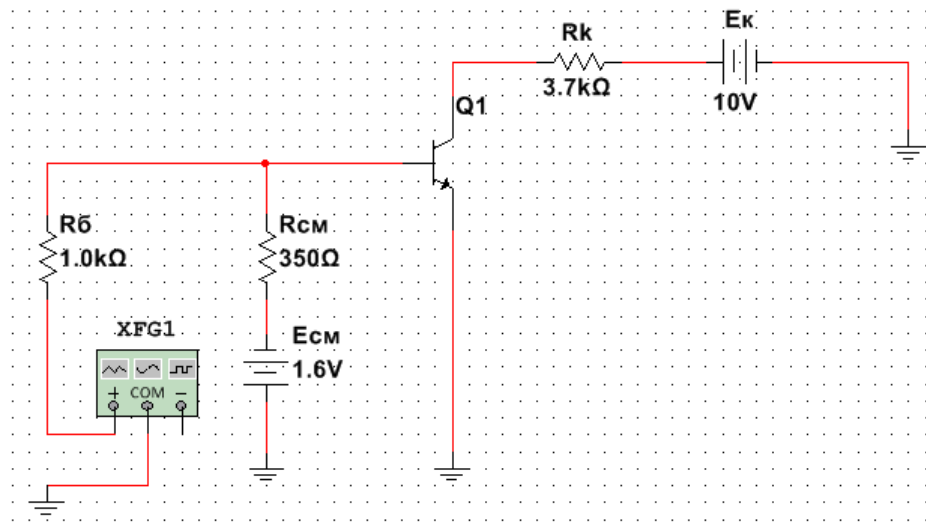
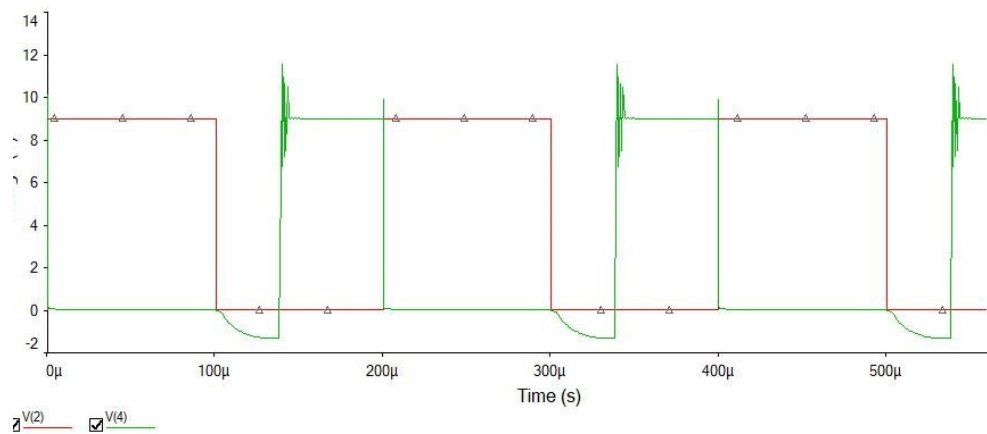


Схема для исследования работы ключа с инверсным запыранием



работа ключа с инверсным запыранием

При инверсном запырании эмиттерный переход запырывается раньше коллекторного. В этом случае рассасывание заряда происходит сначала у эмиттерного перехода. Ток коллектора увеличивается, а ток эмиттера уменьшается, ток базы не меняется.

Вывод: В данной лабораторной работе были исследованы статические режимы и переходные процессы в схеме простого транзисторного ключа. Изучены зависимости τ_{ϕ} , $\tau_{рас}$, $\tau_{ср}$ от входного напряжения и емкости нагрузочного или форсирующего конденсатора, а также рассмотрен режим инверсного запырания ключа.